

4 июня 2019 г.

Открытие конференции

- 10.30-10.35 **К.И. Таперо – Председатель оргкомитета**
(5 мин.) АО «НИИП»
Открытие конференции
- 10.35-10.40 **А.В. Яненко – Зам. председателя оргкомитета**
(5 мин.) АО «ЭНПО СПЭЛС»
Научно-техническая программа конференции

Устные доклады

1. 10.40-11.00 **И.А. Данилов, А.И. Хазанова, А.О. Балбеков, М.С. Горбунов,
(20 мин.) А.А. Антонов**
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН
Маршрут разработки сбоеустойчивых СБИС с помощью программной инъекции сбоев с учетом топологии
2. 11.10-11.30 **В.В. Емельянов**
(20 мин.) АО «НИИП»
Одиночные радиационные эффекты в изделиях электронной техники при воздействии нейтронов реакторного спектра
3. 11.40-12.00 **А.О. Ахметов, А.И. Чумаков, Д.В. Бобровский,
(20 мин.) Г.С. Сорокоумов, А.А. Смолин**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Эффекты прямой ионизации при воздействии протонов – миф или реальность

Перерыв 12.00-13.00 (кофе-брейк)

4. 13.00-13.20 **В.С. Анашин, Г.А. Протопопов, П.А. Чубунов, А.Е. Козюков**
(20 мин.) Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Достоверность результатов испытаний ЭКБ на стойкость к воздействию ИИ КП и риск сокращения САС РЭА КА
5. 13.30-13.50 **Н.Н. Булгаков, И.В. Бахтызин, В.Ф. Зинченко**
(20 мин.) АО «Российские космические системы»
Учет эффекта «усиления дозы» вторичного тормозного излучения при прогнозировании дозовых нагрузок на ЭРИ в составе бортовой аппаратуры космических аппаратов

6. 14.00-14.20
(20 мин.) **Д.И. Сотсков^{1,2}, В.В. Елесин^{1,2}, А.Г. Кузнецов^{1,2},
И.О. Метелкин^{1,2}, Д.М. Амбуркин^{1,2}, Н.А. Усачев^{1,2},
А.С. Будяков³**
¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²НИЯУ МИФИ, ³АО «НПП «Пульсар»
Актуальные вопросы проектирования современной
радиационно-стойкой импортозамещающей ЭКБ твердотельной
СВЧ-электроники, выполненной на основе гетеробиполярных
транзисторов
7. 14.30-14.50
(20 мин.) **Ю.М. Московская^{1,2}, Ю.И. Богданов³, Н.А. Богданова³,
А.В. Согоян^{1,2}, Д.В. Фастовец⁴, В.А. Вазилев⁵**
¹НИЯУ МИФИ, ²АО «ЭНПО СПЭЛС»,
³ФТИАН им. К.А. Валиева РАН, ⁴НИУ МИЭТ, ⁵ПАО «Микрон»
Метод оценки коэффициента радиационной нагрузки при
контроле радиационной стойкости производственных партий
пластин на основе непараметрических статистических
критериев
- Перерыв 15.00-15.30 (кофе-брейк)**
8. 15.30-15.50
(20 мин.) **В.С. Першенков, А.С. Бакеренков, В.А. Фелицын, А.С. Родин,
В.А. Телец, В.В. Беляков, А.И. Жуков**
НИЯУ МИФИ
Физические модели эффектов низкой интенсивности: ELDRS и
RLDRS
9. 16.00-16.20
(20 мин.) **В.Д. Попов**
НИЯУ МИФИ
Явление двухэтапного процесса образования поверхностных
дефектов в МОП-транзисторе при гамма-облучении
10. 16.30-16.50
(20 мин.) **А.С. Петров**
АО «НИИП»
Особенности проявления эффектов низкой интенсивности в
аналоговых изделиях биполярной и БиКМОП-технологии

5 июня 2019 г.

11. 10.00-10.20 (20 мин.) **Е.В. Митин**
ООО «НПЦ «Гранат»
Особенности возникновения и развития эффекта пробоя подзатворного диэлектрика в мощных МОП-транзисторах, облученных тяжелыми заряженными частицами
12. 10.30-10.50 (20 мин.) **П.С. Громова¹, Г.Г. Давыдов^{1,2}, А.В. Мурыгин¹, А.С. Тарараксин^{1,2}, А.С. Колосова^{1,2}, Д.В. Бойченко¹, В.А. Телец², В.Н. Вьюгинов³, В.В. Лучинин⁴**
¹АО «ЭНПО СПЭЛС», ²НИЯУ МИФИ, ³АО «Светлана-Электронприбор», ⁴СПбГЭТУ «ЛЭТИ»
Область безопасной работы современных мощных высоковольтных полупроводниковых приборов
13. 11.00-11.20 (20 мин.) **А.А. Калашникова¹, П.А. Чубунов¹, С.А. Яковлев¹, А.Е. Козюков¹, Р.Р. Мангушев¹, А.В. Нилов¹, А.А. Дрокин¹, А.А. Малова¹, Д.В. Сидоров², В.Ф. Синкевич², П.А. Дюканов², С.В. Корнеев², В.С. Паньков², Л.В. Шеломенцев²**
¹Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП», ²АО «НПП «Пульсар»
Анализ катастрофических отказов биполярных операционных усилителей при воздействии ТЗЧ
14. 11.30-11.50 (20 мин.) **Г.А. Яшин, С.И. Волков, А.А. Глушко, С.А. Морозов, А.С. Новоселов**
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана
Повышение радиационной стойкости транзистора, выполненного по технологии КНИ КМОП 0,5 мкм, к SEL и SEB, вызываемым тяжелыми заряженными частицами

Перерыв 12.00-13.00 (кофе-брейк)

15. 13.00-13.20 (20 мин.) **А.С. Бычков, А.С. Козюков, В.Т. Гаврилов**
Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Актуальные вопросы эксплуатации испытательных стендов контроля стойкости ЭКБ к воздействию ТЗЧ КП
16. 13.30-13.50 (20 мин.) **А.И. Озеров**
АО «НИИП»
Методические вопросы контроля работоспособности ЭКБ при радиационных испытаниях

17. 14.00-14.20 **В.В. Казаков**
(20 мин.) АО «НИИП»
Дозиметрическое сопровождение испытаний ЭРИ и РЭА на стойкость к спецфакторам
18. 14.30-14.50 **Д.А. Амерканов¹, Г.И. Горкин¹, Е.М. Иванов¹,
(20 мин.) С.В. Косьянеко¹, О.В. Лобанов¹, В.Г. Муратов¹, В.В. Пашук¹,
О.А. Щербаков¹, В.А. Тонких¹, А.С. Воробьев¹, В.С. Анашин²,
П.А. Чубунов²**
¹НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ,
²Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Приборная база систем диагностики и транспортировки протонного и нейтронного пучка для радиационных испытаний электроники на синхроциклотроне 1000 МэВ НИЦ КИ ПИЯФ

Перерыв 15.00-15.30 (кофе-брейк)

19. 15.30-15.50 **И.И. Швецов-Шиловский, А.И. Чумаков, А.А. Печенкин,
(20 мин.) Д.В. Бобровский**
НИЯУ МИФИ, АО «ЭНПО СПЭЛС»
Нестабильные тиристорные эффекты в КМОП ИС при воздействии импульсного лазерного излучения
20. 16.00-16.20 **С.И. Бабкин, С.И. Волков, С.А. Морозов, А.С. Новоселов
(20 мин.) ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН**
Исследование параметров высоковольтных LDMOS транзисторов при работе в экстремальных условиях
21. 16.30-16.50 **Б.И. Подлепецкий, В.С. Першенков, А.С. Бакеренков,
(20 мин.) В.А. Фелицын, А.С. Родин**
НИЯУ МИФИ
Влияние температуры и электрических режимов на чувствительность дозиметров ионизирующего излучения на основе МДП транзисторов
22. 16.50-17.10 **А.С. Петров¹, С.К. Труфанов¹, М.С. Мальцева²,
(20 мин.) Т.А. Максименко², А.Е. Козюков²**
¹АО «НИИП», ²Филиал АО «ОРКК» - «НИИ КП»
Влияние предварительного гамма-облучения на стойкость к электростатическому разряду мощных n-МОП транзисторов

17.20-17.50

**Дискуссия, обсуждение стендовых докладов
Предложения в Решение конференции**